



主要特点

工作频率: 2-18 GHz

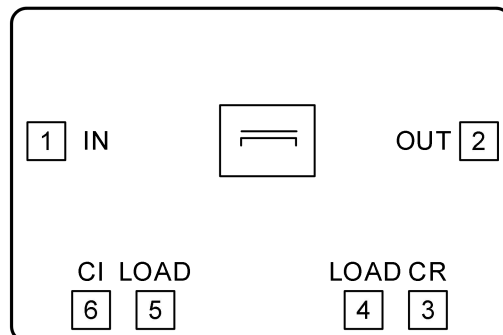
插入损耗: 1.25 dB @ 18 GHz

耦合度: 12 dB

耦合度平坦度: ± 2 dB

芯片尺寸: $3 \times 1.2 \times 0.1$ mm³

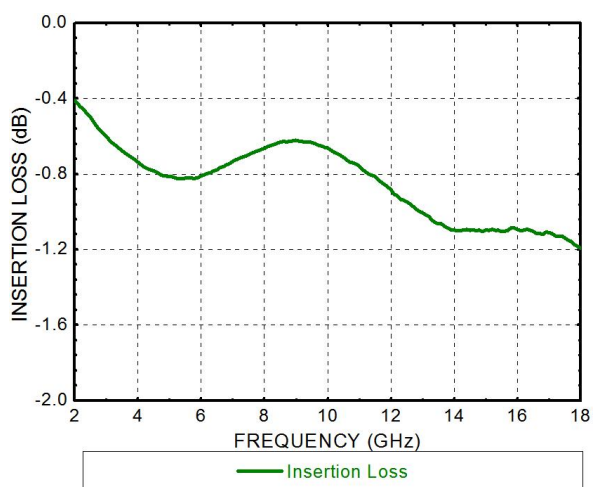
功能框图



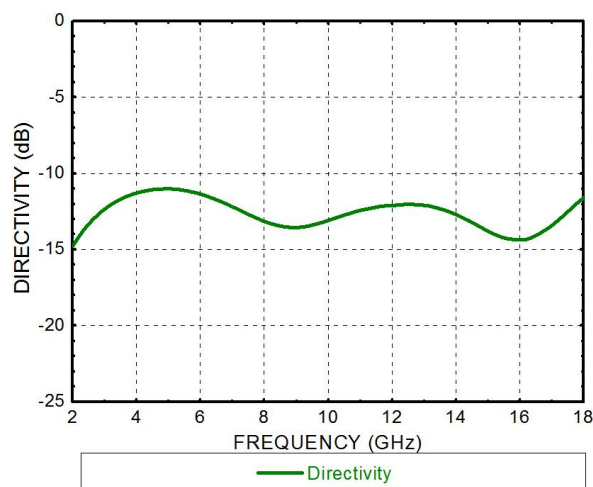
性能指标

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 18			GHz
插入损耗		1		dB
耦合度	10.9	12	14.9	dB
耦合度平坦度		± 2		dB
端口回波损耗		15		dB
隔离度		20		dB

插入损耗



耦合度





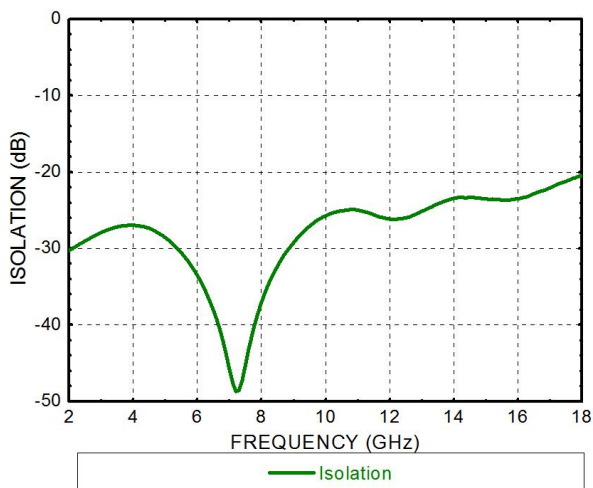
中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2019

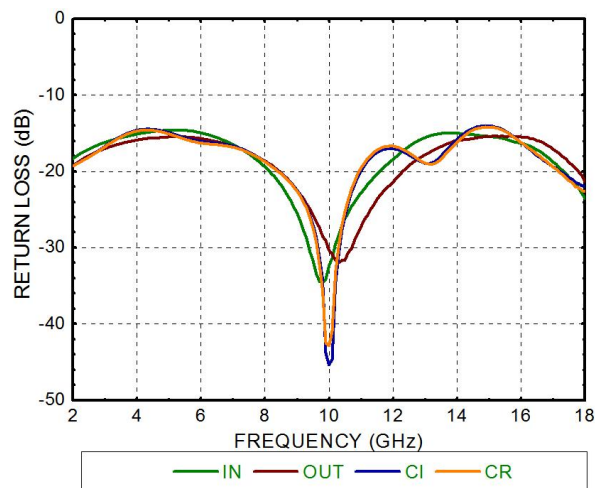
HGC162L

GaAsMMIC
定向耦合器, 2 - 18 GHz

隔离度



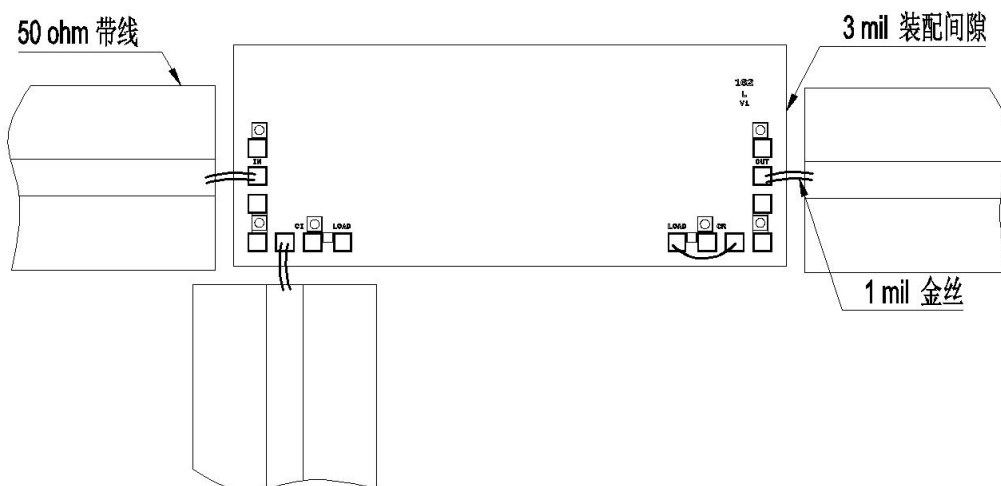
回波损耗



物理参数

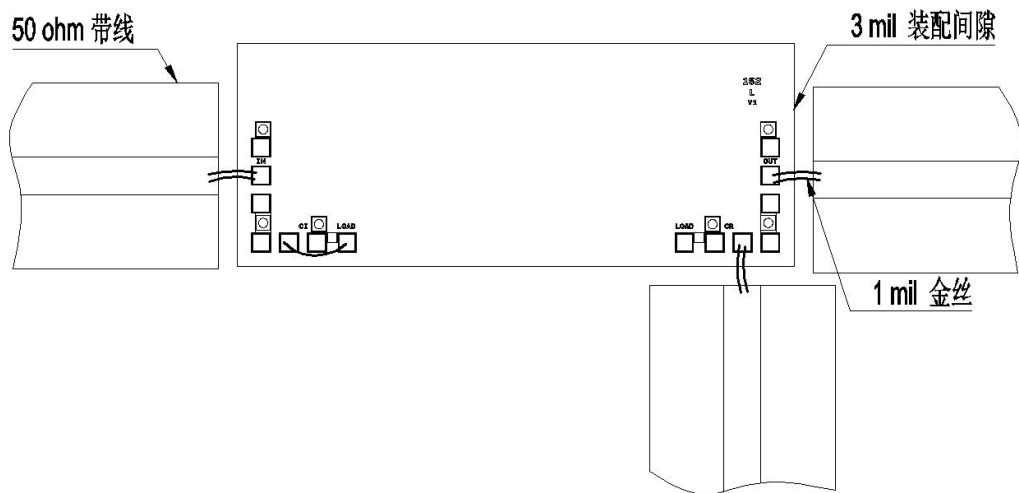


推荐电路图@正向使用





推荐电路图@反向使用



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是射频信号输入端口
2	OUT	该焊盘是射频信号输出端口
3	CR	该焊盘是反向耦合端口
4.5	LOAD	该焊盘是 50 欧姆负载端口
6	CI	该焊盘是正向耦合端口
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	+43 dBm
存储温度	-65 ~ +175° C
工作温度	-55 ~ +85° C